

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第4区分

【発行日】平成25年10月10日(2013.10.10)

【公表番号】特表2012-501511(P2012-501511A)

【公表日】平成24年1月19日(2012.1.19)

【年通号数】公開・登録公報2012-003

【出願番号】特願2011-525009(P2011-525009)

【国際特許分類】

G 11 B 7/24035 (2013.01)

H 01 L 45/00 (2006.01)

H 01 L 27/105 (2006.01)

G 11 B 7/243 (2013.01)

C 03 C 3/32 (2006.01)

B 41 M 5/26 (2006.01)

【F I】

G 11 B 7/24 5 2 2 A

H 01 L 45/00 A

H 01 L 27/10 4 4 8

G 11 B 7/24 5 1 1

C 03 C 3/32

B 41 M 5/26 X

【誤訳訂正書】

【提出日】平成25年8月20日(2013.8.20)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

a. 少なくとも1つの六方晶結晶相を有する組成物からなる結晶化薄膜、または  
b. 結晶化形態で少なくとも1つの六方晶相を有することのできる結晶化可能な組成物、

を備えた物品であって、

前記組成物が、原子パーセントで表して、

5から45のGe、

5から40のAs、またはAsとSbの組合せ、ここで、Asの原子パーセントはSbの原子パーセントよりも大きい、

45から65のTe、および

Al, Si, Ga, Se, In, Sn, Tl, Pb, Bi, P, S、またはそれらの組合せを含むものである、物品。

【請求項2】

前記Al, Si, Ga, Se, In, Sn, Tl, Pb, Bi, P, S、またはそれらの組合せの原子パーセントが20パーセント以下であることを特徴とする請求項1記載の物品。

【請求項3】

前記薄膜が基板上に配置されることを特徴とする請求項1または2記載の物品。

【請求項4】

相変化記憶非晶性材料からなる薄膜を提供し、  
該相変化記憶非晶性材料を六方晶結晶相に転化させる、  
各工程を有してなり、  
前記相変化記憶非晶性材料は、原子パーセントで表して、  
5から45のGe、  
5から40のAs、またはAsとSbの組合せ、ここで、Asの原子パーセントはSb  
の原子パーセントよりも大きい、  
45から65のTe、および  
Al, Si, Ga, Se, In, Sn, Tl, Pb, Bi, P, S、またはそれらの組  
合せを含むものである、

方法。

#### 【請求項5】

六方晶結晶相を有する相変化記憶材料からなる薄膜を提供し、  
該六方晶結晶相を非晶相に転化させる、  
各工程を有してなり、  
前記相変化記憶材料は、原子パーセントで表して、  
5から45のGe、  
5から40のAs、またはAsとSbの組合せ、ここで、Asの原子パーセントはSb  
の原子パーセントよりも大きい、  
45から65のTe、および  
Al, Si, Ga, Se, In, Sn, Tl, Pb, Bi, P, S、またはそれらの組  
合せを含むものである、

方法。

#### 【誤訳訂正2】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0009

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0009】

本発明の1つの実施の形態は、少なくとも1つの六方晶相を有する組成物からなる結晶化薄膜、または結晶化形態で少なくとも1つの六方晶相を有することのできる結晶化可能な組成物を備えた物品である。

#### 【誤訳訂正3】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0018

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0018】

本発明の1つの実施の形態は、少なくとも1つの六方晶相を有する組成物からなる結晶化薄膜、または結晶化形態で少なくとも1つの六方晶相を有することのできる結晶化可能な組成物を備えた物品である。